CLIPPEDIMAGE= JP404230060A

PAT-NO: JP404230060A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04230060 A

TITLE: COOLING STRUCTURE

PUBN-DATE: August 19, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MOCHIZUKI, MASAHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

FUJITSU LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP02415321

APPL-DATE: December 27, 1990

INT-CL (IPC): H01L023/36

US-CL-CURRENT: 257/714,257/718

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve heat conduction between LSIs and conductive members or heat conduction between a heat dissipation block and the conductive members by a method wherein the conductive members are formed into a split type in the longitudinal direction and elastic materials to energize the conductive members in the direction of the block are respectively provided in the conductive members.

CONSTITUTION: In a cooling structure consisting of a heat dissipation block 4 having conductive members (studs) 12, which are abutted on integrated circuit elements (LSIs) 2 mounted on a substrate 1 and are elastically supported, and a

cold plate 3 having a refrigerant passage 8, which comes into contact with this

block 4 and in which a refrigerant is fluidized, an elastic member (a spring)

12c to energize split conductive members 12a and 12b toward the outside

direction is provided in the opposed surface of conductive members 12a and 12b

to be formed into one by opposing to each other to the split conductive members

12a and 12b. Or an elastic member (a plate spring) 14d is inscribed in a

recessed part (a groove) 14c with a conductive member (a stud) 14a having the

recessed part 14c in its external surface and is energized in the outside

direction so as to bring the opposite surface to a recessed part formation

surface of the member 14a into contact with the block 4.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

(19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開平4-230060

(43)公開日 平成4年(1992)8月19日

(51) Int.Cl.5

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 23/36

7220-4M

庁内整理番号

H01L 23/36

D

審査請求 未請求 請求項の数4(全 7 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平2-415321

平成2年(1990)12月27日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 望月 優宏

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

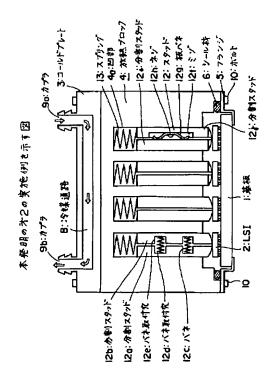
(74)代理人 弁理士 山川 雅男 (外1名)

(54) 【発明の名称】 冷却構造

(57)【要約】

【目的】本発明は、LSIと伝導部材間の熱伝導を、ま たは放熱プロックと伝導部材間の熱伝導を向上させるこ とを目的とする。

【構成】LSIと当接する伝導部材を分割してLSIと 伝導部材間の多点接触を行う、または伝導部材に常時放 熱プロック側に付勢してなる弾性体を設けることで、放 熱プロックと伝導部材間の多点接触を行うよう構成す る。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板(1)上に実装された集積回路素子(2)と当接し、弾性支持された伝導部材(7)を有する放熱プロック(4)と、該放熱プロック(4)と接触し、その内部に冷媒が流動する冷媒通路(8)を有するコールドプレート(3)とからなる冷却構造において、前記伝導部材(7)は、円柱状のスタッド(7a)と、該スタッド(7a)を弾性的に支持するベローズ(7f)と、該スタッド(7a)および該ベローズ(7f)をその内部に有する円筒状のパイプ(7b)と、該パイ 10プ(7b)を弾性的に支持するベローズ(7e)と、から構成されたことを特徴とする冷却構造。

【請求項2】 基板(1)上に実装された集積回路素子(2)と当接し、弾性支持された伝導部材(12)を有する放熱プロック(4)と、該放熱プロック(4)と接触し、その内部に冷媒が流動する冷媒通路(8)を有するコールドプレート(3)とからなる冷却構造において、対向することで1つに形成される前記伝導部材(12a,12b,12j)と、分割された分割伝導部材(12a,12b)を外側方向に向かって付勢する弾性部材(12c)を設けたことを特徴とする冷却構造。

【請求項3】 基板(1)上に実装された集積回路素子(2)と当接し、弾性支持された伝導部材(14a)を有する放熱プロック(4)と、該放熱プロック(4)と接触し、その内部に冷媒が流動する冷媒通路(8)を有するコールドプレート(3)とからなる冷却構造において、その外面の任意の部分に凹部(14c)を有する前記伝導部材(14a)と、該凹部(14c)内に内接され、該伝導部材(14a)の凹部形成面との反対の面を30放熱プロック(4)に接触させるよう外側方向に付勢する弾性体(14d)と、から構成されたことを特徴とする冷却構造。

【請求項4】 基板(1)上に実装された集積回路素子(2)と当接し、弾性支持された伝導部材(15)を有する放熱プロック(4)と、該放熱プロック(4)と接触し、その内部に冷媒が流動する冷媒通路(8)を有するコールドプレート(3)とからなる冷却構造において、前記伝導部材(15)の弾性支持面の所定の傾斜をもってスライスし、該スライスされた面に該傾斜面を滑40動して該伝導部材(15)を偏心支持すると共に、弾性支持された補助伝導部材(16)を設けたことを特徴とする冷却構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、冷却構造に係り、特に基板上に実装された集積回路素子(以下、LSIと称する)に弾性支持された伝導部材を当接させ、コールドプレート内の冷媒との熱交換によって当該LSIの冷却を行う冷却構造に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来は、図15に示すように、LSI2 1が搭載された基板20に対して、フランジ24を介して熱伝導性に優れた部材によりなる放熱プロック23を取り付ける。この放熱プロック23の背面には、その内部に冷媒が流動する冷媒通路28を有するコールドプレート22が接合される。尚、冷媒通路28の両端には配管接続用のカプラ29a,29bがそれぞれ取り付けられている。

【0003】上記放熱プロック23には、基板20上のLSI21の実装位置に対応して凹部23aが形成され、その中に熱伝導性に優れたスタッド26がスプリング27を介して取り付けられる。上記スプリング27は基板20上に実装されるLSI21の実装高さの調節を行うもので、またスタッド26のLSI21と当接する面は接触の確実さを実現するためにR曲面となっている。尚、放熱プロック23と基板20との間にはシール性を高めるためにシール材25が取り付けられている。

2 a, 1 2 b, 1 2 i, 1 2 j) と、分割された分割伝【0 0 0 4】上記構成において、冷却時の熱は、まずL導部材(1 2 a, 1 2 b) の対向面に、該分割伝導部材20(1 2 a, 1 2 b) を外側方向に向かって付勢する弾性よび放熱プロック2 3 との間接熱伝導によってその熱が部材(1 2 c) を設けたことを特徴とする冷却構造。伝わり、コールドプレート 2 2 との熱交換を行うように【請求項3】 基板(1)上に実装された集積回路素子なっていた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしなから、従来では、いくらスプリングによってLSIとスタッドの接触を保証しても、結局は一点接触にしかすぎず、また放熱プロックとスタッドが直接接触している部分が殆どないため、熱伝導性に劣るという問題があった。

【0006】従って、本発明は、LSIと伝導部材間の 熱伝導を、または放熱プロックと伝導部材間の熱伝導を 向上させることを目的とするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的は、基板1上に 実装された集積回路素子2と当接し、弾性支持された伝 導部材7を有する放熱プロック4と、該放熱プロック4 と接触し、その内部に冷媒が流動する冷媒通路8を有す るコールドプレート3とからなる冷却構造において、前 配伝導部材7は、円柱状のスタッド7aと、該スタッド7 aを弾性的に支持するベローズ7fと、該スタッド7 aおよび該ベローズ7fをその内部に有する円筒状のパ イプ7bと、該パイプ7bを弾性的に支持するベローズ 7eと、から構成されたことを特徴とする冷却構造、

【0008】または、基板1上に実装された集積回路素子2と当接し、弾性支持された伝導部材12を有する放熱プロック4と接触し、その内部に冷媒が流動する冷媒通路8を有するコールドプレート3とからなる冷却構造において、対向することで1つに形成される前記伝導部材12a,12bと、分割伝導部材12a,12bの対向面に、該分割伝導部

材12a、12bを外側方向に向かって付勢する弾性部 材12cを設けたことを特徴とする冷却構造、

【0009】または、基板1上に実装された集積回路素 子2と当接し、弾性支持された伝導部材14aを有する 放熱プロック4と、該放熱プロック4と接触し、その内 部に冷媒が流動する冷媒通路8を有するコールドプレー ト3とからなる冷却構造において、その外面の任意の部 分に凹部14cを有する前記伝導部材14aと、該凹部 14 c 内に内接され、該伝導部材14 a の凹部形成面と の反対の面を放熱プロック4に接触させるよう外側方向 10 に付勢する弾性体14dと、から構成されたことを特徴 とする冷却構造、

【0010】または、基板1上に実装された集積回路素 子2と当接し、弾性支持された伝導部材15を有する放 熱プロック4と、該放熱プロック4と接触し、その内部 に冷媒が流動する冷媒通路8を有するコールドプレート 3とからなる冷却構造において、前配伝導部材15の弾 性支持面の所定の傾斜をもってスライスし、該スライス された面に該傾斜面を滑動して該伝導部材15を偏心支 持すると共に、弾性支持された補助伝導部材16を設け 20 たことを特徴とする冷却構造、によって達成することが できる。

[0011]

【作用】即ち、本発明においては、伝導部材を長手方向 の分割型とすることで、当該伝導部材とLSIとの間の 接触を多点接触とすることができ、また、伝導部材内に 伝導部材を放熱プロックの方向へと付勢してなる弾性材 を設けることにより、放熱プロックに伝導部材を直接接 触することができる。

[0012]

【実施例】以下、本発明の望ましい実施例について図1 乃至図14を用いて詳細に説明する。

【0013】図1は本発明の第1の実施例を示す図であ り、図2はスタッド分解図であり、図3は熱伝導状態を 示す図であり、図4は本発明の第2の実施例を示す図で あり、図5はスタッド分解図(その1)であり、図6は スタッド分解図(その2)であり、図7は熱伝導状態を 示す図(その1)であり、図8は熱伝導状態を示す図 (その2)であり、図9は本発明の第3の実施例を示す 図であり、図10はスタッド分解図(その1)であり、 図11はスタッド分解図(その2)であり、図12は熱 伝導状態を示す図であり、図13は本発明の第4の実施 例を示す図であり、図14は熱伝導状態を示す図であ

【0014】図1乃至図14において、1は基板、2は LSI, 3はコールドプレート, 4は放熱プロック, 4 aは凹部, 5はフランジ, 6はシール材, 7はスタッ ド, 7aと7bはパイプ, 7cはスタッド, 7d~7f はペローズ, 8は冷媒通路, 9 a と 9 b はカプラ, 10 はポルト、11はバンプ、12は伝導部材、12aと1 50 は長手方向に二等分され、その分割された分割スタッド

2 bと12 i と12 j は分割スタッド、12 c はバネ、 12dと12eはパネ取付穴、12fはミゾ、12gは 板パネ、12hネジ、13はスプリング、14aと14 bはスタッド、14cミゾ、14dは板パネ、14eは ネジ, 14 f は凹部, 14 g はパネ, 14 h はポール, 141はネジ穴、15a~15dはスタッド、16aと 16 bはサブスタッド、17はポールをそれぞれ示す。 【0015】尚、図1乃至図14において同一符号を付 したものは同一対象物をそれぞれ示すものである。

【0016】まず、第1の実施例について図1乃至図3 を用いて詳細に説明する。図1に示すように、LSI2 が搭載された基板1に対してフランジ5を介し熱伝導性 に優れた部材によりなる放熱ブロック4を取り付ける。 基板1と放熱プロック4の間のシール性を高めるために その接合点にはシール材6を設けている。一方、放熱プ ロック4の背面には内部に冷媒が流動する冷媒通路8を 有するコールドプレート3が接触される。

【0017】一方、放熱プロック4には、LSI実装位 置に対応して凹部4 aが形成され、その凹部4 a内に図 2に示すスタッド7が形成される。このスタッド7は、 その中心に位置する円柱状のスタッド7aに対して、そ の回りを覆う円筒状のパイプ7 bおよびその円筒状のパ イプ7bをも覆ってしまう同じく円筒状のパイプ7cを 設け、それらスタッド7aおよび2つのパイプ7b、7 cにはベローズ7d~7fの弾性体が取り付けられる。 尚、上記凹部4aの奥側は取付時の問題から階段状とす ることが望ましい。

【0018】図3は第1の実施例における熱伝導状態を 示す図であり、基板上に実装されるLSIの実装高さに 30 パンプの接合状態でバラツキが発生した場合を示してい る。LSIの放熱面に接触するスタッドは本実施例にお いては、LSIの放熱面に凹凸がない以上、スタッドを 構成するスタッド7cと2つのパイプ7a,7bによっ て必ず三点接触 (図示①~③) が保証される。本例にお いて放熱プロックの凹部の径とスタッドの径との距離に 充分余裕があれば1つの点接触と2つの円形の線接触を 得ることができ、LSIからスタッドへの熱伝導率を向 上することができる。

【0019】次に第2の実施例について図4乃至図8を 40 用いて詳細に説明する。図4に示すように、LSI2が 搭載された基板1に対してフランジ5を介し熱伝導性に 優れた部材によりなる放熱ブロック4を取り付ける。基 板1と放熱プロック4の間のシール性を高めるためにそ の接合点にはシール材6を設けている。一方、放熱プロ ック4の背面には内部に冷媒が流動する冷媒通路8を有 するコールドプレート3が接触される。

【0020】一方、放熱プロック4には、LSI実装位 置に対応して凹部4aが形成され、その凹部4a内に図 5に示すスタッド12が形成される。このスタッド12

12a, 12bにはそれぞれ2ヵ所にバネ取付穴12d が形成される。そしてそのパネ取付穴12dには図示上 下方向に付勢するパネ12cが取り付けられる。

【0021】また図6には、分割スタッドの変形例を示 すもので、上記と同様に長手方向に二分割された分割ス タッド121,121の一方の分割スタッド121に、 長手方向にミゾ12 fを形成し、その中心部分にはネジ 穴が穿孔されている。そして、このミゾ12 f に側面視 V型のパネ性を有する板パネ12gをネジ12hによっ て締結される。この板バネ12gは図示上下方向に付勢 10 うに線接触を得ることができる。尚、放熱プロック4に するバネ性を有している。

【0022】このようなスタッド12は放熱プロック4 にスプリング13によって取り付けられ、基板1上に実 装されたLSI2の高さ方向のパラツキを調節するよう になっている。

【0023】図7及び図8は第2の実施例における熱伝 導状態を示す図であり、図7はその側面視図である。図 7において、基板1上に実装されたLSI2に対し、そ の放熱面にスタッド12を接触させる。このLSI2と 現することができると共に、分割スタッド12a、12 bの中に設けたパネ12cによって放熱プロック4とは 長手方向にbとcに示すように線接触を行うことができ る(図8の上面図参照)。尚、分割スタッド12iと1 2jの場合においてもパネ12cが板パネ12gに代わ るだけで、作用・効果は同様である。従って、本例では LSI2とスタッド12の熱伝導率を向上すると共に、 スタッド12と放熱プロック4との熱伝導率をも向上す ることができる。

【0024】次に第3の実施例について図9乃至図12 を用いて詳細に説明する。図9に示すように、LSI2 が搭載された基板1に対してフランジ5を介し熱伝導性 に優れた部材によりなる放熱プロック4を取り付ける。 基板1と放熱プロック4の間のシール性を高めるために その接合点にはシール材6を設けている。一方、放熱プ ロック4の背面には内部に冷媒が流動する冷媒通路8を 有するコールドプレート3が接触される。

【0025】一方、放熱プロック4には、LSI実装位 置に対応して凹部4aが形成され、その凹部4a内に図 10に示すスタッド14aが形成される。このスタッド 40 14 a は長手方向に所定長を有するミゾ14 c が形成さ れ、そのミゾ14c内にネジ穴14iが穿孔される。こ のネジ穴14iにはネジ14eによって板パネ14dが 締結される。この板パネ14dは図示上方向に付勢する パネ性を有している。

【0026】また図11には、スタッドの変形例を示す もので、スタッド14bには任意の部分に凹部14fが 形成され、その凹部14 f 内に図示上下方向に付勢して なるパネ14gが内接される。そのパネ14gの先端に はポール14hが取り付けられている。

【0027】このようなスタッド14a, 14bは放熱

プロック4にスプリング13によって取り付けられ、基 板1上に実装されたLSI2の高さ方向のパラツキを調 節するようになっている。

【0028】図12は第3の実施例における熱伝導状態 を示す図であり、図12において基板1上に実装された LSI2の放熱面にスタッド14aを当接される。この 時、スリッド14a内に設けられた板パネ14dによっ て板パネ14dと反する面が放熱プロックとdに示すよ 板パネ14 dが接する部分についても熱伝導を行うこと ができる。従って、本例においてはスタッド14aと放 熱プロック4巻の熱伝導を向上することができる。尚、 スリッド14bの場合においても板パネ14dがポール 14 hに代わるだけで、作用・効果はスタッド14 aと 同様である。

【0029】最後に第4の実施例について図13および 図14を用いて詳細に説明する。図13に示すように、 LSI2が搭載された基板1に対してフランジ5を介し スタッド12の接触点はaにて示すように二点接触を実 20 熱伝導性に優れた部材によりなる放熱プロック4を取り 付ける。基板1と放熱プロック4の間のシール性を高め るためにその接合点にはシール材6を設けている。一 方、放熱プロック4の背面には内部に冷媒が流動する冷 媒通路8を有するコールドプレート3が接触される。

> 【0030】一方、放熱プロック4には、LSI実装位 置に対応して凹部4aが形成され,その凹部4a内にス タッドが形成されるが、このスタッド14aは所定角度 をもって斜め方向にスライスされており、そのスライス された面にはポール17が設けられ、そのポール17に 30 LSI2の実装のパラツキを調節するスプリング13が 設けられている。スタッド15bのスライス面に当接す る部分の他の例として、そのスライスされた面には表面 がR曲面となったサプスタッド16bを設ける。更にス タッド15c, 15dのスライス面に当接する部分の他 の例として、そのスライスされた面には上記所定角度と 同様の角度を対向面に有するサプスタッド16aを設け る。これらサプスタッド16a, 16bにはLSI2の 実装上のパラツキを調節するスプリング13が取り付け られている。

> 【0031】図14に第4の実施例における熱伝導状態 を示す図であり、基板1上に実装されたLSI2に対し **てスライス面を有するスタッド15cを当接させる。そ** して、このスライス面にはサプスタット16bが当接す るが、この時スプリング13の付勢及びサブスタッド1 6 bの自重により、基板方向と基板と平行な方向にその 力が働く。すると、サプスタッド16bは放熱プロック 4に線接触すると共に、スタッド15cのサブスタッド 側先端部分が放熱プロック4に線接触することとなる。 放熱プロック4とスタッドとの間にある程度の余裕があ 50 るのであればスタッド15cのLSI側先端部分も放熱

プロック4に線接触することとなる。このことはポール 17の場合も、先端にR曲面を有するサプスタッド16 aの場合もその作用・効果は同様である(但し、ポール 17を用いた場合は放熱プロック4との接触は点接触に なるが)。従って、本例においてはスタッド15a~1 5 d と放熱プロック 4 との熱伝導率を向上することがで きる。

[0032]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、ス タッドとLSI間の、スタッドと放熱プロックとの熱伝 10 1:基板 導率を向上することができることから、冷却能力を向上 することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の第1の実施例を示す図である。
- 【図2】スタッド分解図である。
- 【図3】熱伝導状態を示す図である。
- 【図4】本発明の第2の実施例を示す図である。
- 【図5】スタッド分解図である(その1)。
- 【図6】スタッド分解図である(その2)。
- 【図7】熱伝導状態を示す図である(その1)。

【図8】熱伝導状態を示す図である(その2)。

【図9】本発明の第3の実施例を示す図である。

【図10】スタッド分解図である(その1)。

【図11】スタッド分解図である(その2)。

【図12】熱伝導状態を示す図である。

【図13】本発明の第4の実施例を示す図である。

【図14】熱伝導状態を示す図である。

【図15】従来例を示す図である。

【符号の説明】

2:LSI (集積

回路素子)

3:コールドプレート

4:放熱ブロック

7, 12, 14a, 14b, 15:スタッド (伝導部

材)

7 a, 7 b:パイプ

7e, 7f:ペロ

ーズ

8:冷媒通路

12c:パネ (弾

性部材)

14 c:ミゾ (凹部)

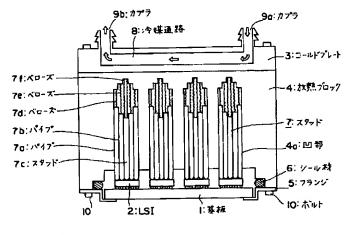
14d:板パネ

20 (弹性体)

【図1】

【図2】

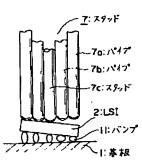
本発明の汁しの実施例を示す団



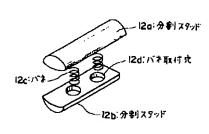
【図3】

【図5】

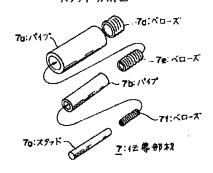
熱伝導状態8示す図



スタッド分解図(その)

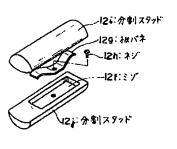


スタッド 分解図



[図6]

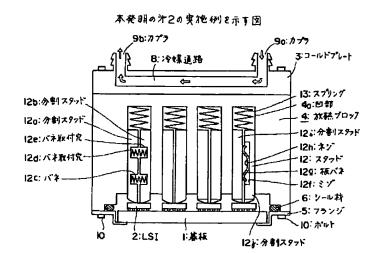
スタッド分解図 (その2)

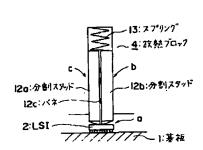


【図4】

【図7】

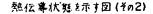
熱伝導状態を示す図(その1)

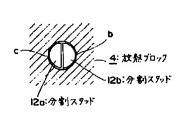




【図8】

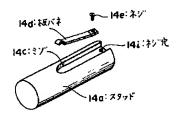
【図9】

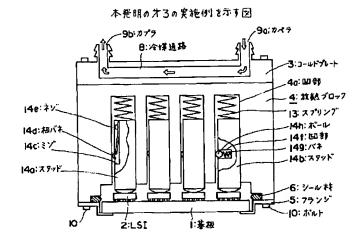




【図10】

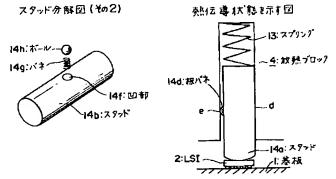






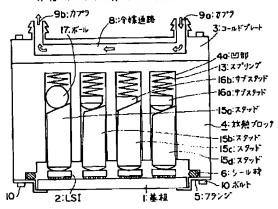
【図11】

【図12】



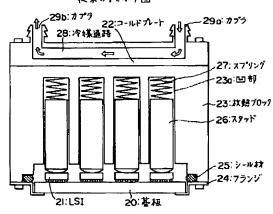
【図13】

本発明の沖4の実施例を示す団



【図15】

提来例 t示す図



【図14】

熱伝導状態を示す図

